摂動を加えたときの Schwinger機構

田屋 英俊 (Fudan University)

Refs: [<u>HT</u>, PRD 99, 056006 (2019)] [Huang, <u>HT</u>, PRD 100, 016013 (2019)]



考えた 「強い遅い電場 + <u>任意に</u>時間依存する弱い電場」をかけた ときのSchwinger機構 (dynamically assisted Schwinger 機構)



Schwinger公式を超える、解析的公式をはじめて導出 ⇒これまで解析的に議論できなかったパラメタ領域の議論が可能に



- dynamically assisted Schwinger 機構と
 物性のFranz-Keldysh効果は本質的に同じものである
- ・スピン依存する粒子生成が起こる





・強い電場を真空に加えると、電子・陽電子対が生成される



•

•



・強い電場を真空に加えると、電子・陽電子対が生成される



・さまざまな極限状況で、実際に起こっている、と期待
 e.g.) 重イオン衝突初期、超重原子(Z>173)、高強度レーザー、初期宇宙



・強い電場を真空に加えると、電子・陽電子対が生成される



- ・さまざまな極限状況で、実際に起こっている、と期待
 e.g.) 重イオン衝突初期、超重原子(Z>173)、高強度レーザー、初期宇宙
- ・電場の周波数 $\Omega(E = E_0 \cos(\Omega t))$ に応じ、三種類に大別できる

(1) 遅い電場 (Ω小) Schwinger機構

(2) 速い電場 (Ω大)

multi-photon pair production

(3) 重ね合わせ (遅い+速い電場) dynamically assisted Schwinger 機構



[Sauter (1932)] [Heisenberg, Euler (1936)] [Schwinger (1951)]

電場がバンドを曲げる ⇒ level crossing ⇒ <u>非摂動的な</u>トンネル効果





[Sauter (1932)] [Heisenberg, Euler (1936)] [Schwinger (1951)]

電場がバンドを曲げる ⇒ level crossing ⇒ <u>非摂動的な</u>トンネル効果



🙂 よくわかっている

(1) 物性物理の「絶縁破壊 (Landau-Zener 転移)」のアナログ

[Landau (1932)][Zener (1932)][Majorana (1932)][Stueckelberg (1932)]

(2) 生成スペクトルは解析的に計算可 (ガウシアン + スピン非依存)

Schwingerの公式:
$$\frac{d^3N_{\uparrow}}{dp^3} = \frac{d^3N_{\downarrow}}{dp^3} = \frac{V}{(2\pi)^3} \exp\left[-\frac{\pi(m^2+p_T^2)}{eE}\right]$$



光子の粒子性が効いてくる ⇒ 光子と<u>摂動的に</u>多重散乱





光子の粒子性が効いてくる ⇒ 光子と<u>摂動的に</u>多重散乱



🙂 よくわかっている

(1) 物性物理の「光電効果」のアナログ [Einstein (1905)]

(2) 生成スペクトルは解析的に計算可 (デルタ関数 + スピン非依存)

摂動論による公式: $\frac{d^3N_{\uparrow}}{dp^3} = \frac{d^3N_{\downarrow}}{dp^3} = \# \times \left(\frac{eE}{m^2 + p^2}\right)^2 \delta(2\sqrt{m^2 + p^2} - \Omega)$



遅い電場による非摂動トンネル効果 + 速い電場による摂動的多重散乱



(3) 重ね合わせたとき = dynamically assisted [Dunne, Gies, Schutzhold (2008), (2009)][Piazza et al (2009)][Monin, Voloshin (2010)] Schwinger 機構

遅い電場による非摂動トンネル効果 + 速い電場による摂動的多重散乱



③ あまりよくわかっていない

(1) 物性物理のアナログが何かわかっていない

(2) 生成スペクトルの解析的公式はない

- 数値計算によると、スペクトルは、ガウシアン+デルタ関数という 単純な重ね合わせではなく、これを<u>解析計算で再現できていない</u>
 cf. 電場が十分に断熱的なら、準古典的方法 (WKBやworldline法) が使える
- スピン自由度の議論は<u>まったくなかった</u>



「dynamically assisted Schwinger 機構」 の理解を深める



生成スペクトルの解析的公式を求める

メモ: 重イオン衝突にも重要

R

- e.g. ・ 衝突初期は、glasma + (mini-)jets で、正にdyn. ass. Schwinger 機構が起こる状況 (強く遅い電磁場) + (弱く速い電磁場)
 - ・Lund模型は、ソフトとハードの粒子生成を単なる重ね合わせで書くが、 これは、正確には、正しくない

<u>主張</u>: Franz-Keldysh効果が[A]の答えだ

半導体に、遅く強い電場と光子(~速い電場)を当て、光子吸収率を測る

- ⇒ 光子の吸収率 ~ 1-loop有効作用の虚部 ~ 粒子生成率
- ⇒とてもdynamically assisted Schwinger 機構に似てるように見える

<u>主張</u>: Franz-Keldysh効果が[A]の答えだ 半導体に、遅く強い電場と光子(~速い電場)を当て、光子吸収率を測る

⇒ 光子の吸収率 ~ 1-loop有効作用の虚部 ~ 粒子生成率

⇒とてもdynamically assisted Schwinger 機構に似てるように見える



<u>主張</u>: Franz-Keldysh効果が[A]の答えだ 半導体に、遅く強い電場と光子(~速い電場)を当て、光子吸収率を測る

⇒ 光子の吸収率 ~ 1-loop有効作用の虚部 ~ 粒子生成率

⇒とてもdynamically assisted Schwinger 機構に似てるように見える



ギャップの (1) 下では、吸収率が増大; (2) 上では、吸収率が振動

TO-do スペクトルの解析的公式を求め[目的B]、(1)(2)がSchwinger 機構でも起きることを確かめることで、この主張を示す[目的A]





GOAL

遅い電場 E_s と速い電場 \mathcal{E}_f があるときの 粒子数期待値 $\frac{d^3N}{dp^3} = \langle \hat{a}_{p,s}^{\dagger} | \hat{a}_{p,s} \rangle$ を計算したい



GOAL

遅い電場 E_s と速い電場 \mathcal{E}_f があるときの 粒子数期待値 $\frac{d^3N}{dp^3} = \langle \hat{a}_{p,s}^{\dagger} \hat{a}_{p,s} \rangle$ を計算したい

遅い/速い電場は非摂動的/摂動的に効くのだから、遅い電場は非摂動的に取り扱う必要があるが、速い電場については摂動的な取扱いで十分



GOAL

遅い電場 E_s と速い電場 \mathcal{E}_f があるときの 粒子数期待値 $\frac{d^3N}{dp^3} = \langle \hat{a}_{p,s}^{\dagger} \hat{a}_{p,s} \rangle$ を計算したい

遅い/速い電場は非摂動的/摂動的に効くのだから、遅い電場は非摂動的に取り扱う必要があるが、速い電場については摂動的な取扱いで十分

$\hat{a}_{p,s}$ を速い電場 $\mathcal{E}_{\mathbf{f}}$ についてだけ摂動展開して計算する

理論(2/2): 外場中の摂動論(Furry描像)
STEP 1 全体の電場Eを、遅い電場E_sと速い電場E_tに分ける

$$E = E_s + \varepsilon_t$$

STEP 2 Dirac方程式を、遅い電場E_sに非摂動的に、速い電場E_tに摂動的に解く
 $[i\partial - eA_s - m]\hat{\psi} = eA_t\hat{\psi}$
 $\hat{\psi}(x) = \hat{\psi}^{(0)}(x) + \int_{-\infty}^{\infty} dy^4 S(x,y)eA_t(y)\hat{\psi}^{(0)}(y) + O(|eA_t|^2)$
ここで、未摂動波動関数 $\hat{\psi}^{(0)}$ とプロパゲータSは、E_sに非摂動的にドレスされてる
 $[i\partial - eA_s - m]\hat{\psi}^{(0)} = 0$
 $[i\partial - eA_s - m]S(x,y) = \delta^4(x - y)$
STEP 3 生成消滅演算子 $\hat{a}_{p,s}^{in/out}$, $\hat{b}_{p,s}^{in/out}$ を $\hat{\psi}$ から求める
無限の未来/過去で、平面波で内積を取ればよい(断熱仮説)
 $\left(\hat{a}_{p,s}^{in/out}\right) = \lim_{t \to -\infty/+\infty} \int d^3x \left(\frac{(u_{p,s}e^{-i\omega_p t}e^{ip\cdot x})^{\dagger}}{(v_{p,s}e^{+i\omega_p t}e^{ip\cdot x})^{\dagger}}\right)\hat{\psi}(x)$
STEP 4 粒子数期待値(vac; in $|a_{p,s}^{out+}a_{p,s}^{out}|vac; in}$ を計算する



結果(1/3): 公式 (遅い/速い電場が平行)

 $\frac{d^{3}N_{e}}{dp^{3}} = \frac{V}{(2\pi)^{3}} \exp\left[-\frac{\pi(m^{2}+p_{\perp}^{2})}{eE_{s}}\right] \times \left|1 + \frac{1}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}\int_{0}^{\infty}d\omega\frac{\tilde{\mathcal{E}}_{f}(\omega)}{E_{s}}\exp\left[-\frac{i}{4}\frac{\omega^{2}+4\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}\right]{}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 2; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right)\right|^{2}$

$$\frac{d^{3}N_{e}}{dp^{3}} = \frac{V}{(2\pi)^{3}} \exp\left[-\frac{\pi(m^{2}+p_{\perp}^{2})}{eE_{s}}\right] \times \left|1 + \frac{1}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}\int_{0}^{\infty}d\omega\frac{\tilde{\mathcal{E}}_{f}(\omega)}{E_{s}} \exp\left[-\frac{i}{4}\frac{\omega^{2}+4\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}\right]{}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 2; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right)\right|^{2}$$

普通のSchwinger機構 by 遅い電場E_s





・遅い極限 ω/√<u>eE</u>s ≪ 1: ■ が支配的 **⇒ Schwingerの公式を再現**



・遅い極限 $\omega/\sqrt{eE_s} \ll 1$:
が支配的
⇒ Schwingerの公式を再現

 \checkmark

Schwingerの公式を超えた、時間依存電場に対する 粒子生成の解析的な公式をはじめて導出した!

結果(2/3): 公式 (遅い/速い電場が平行でない)

$$\begin{aligned} \frac{d^{3}N_{e}}{dp^{3}} &= \frac{V}{(2\pi)^{3}} \exp\left[-\frac{\pi(m^{2}+p_{\perp}^{2})}{eE_{s}}\right] \\ &\times \left[\left| 1 + \int_{0}^{\infty} d\omega \, \mathrm{e}^{-i\frac{\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}} \frac{1}{2} \frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}} \frac{\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{f}}(\omega) \cdot \mathbf{E}_{s}}{E_{s}^{2}} \, \mathrm{e}^{-i\frac{\omega^{2}}{4eE_{s}}} {}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 2; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right) \right. \\ &+ i \int_{0}^{\infty} d\omega \, \mathrm{e}^{-i\frac{\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}} \frac{\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{f}}(\omega) \cdot p_{\perp}}{E_{s}\omega} \, \mathrm{Re}\left[\mathrm{e}^{-i\frac{\omega^{2}}{4eE_{s}}} {}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 1; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right) \right] \\ &+ s \times i \int_{0}^{\infty} d\omega \, \mathrm{e}^{-i\frac{\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}} \frac{(\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{f}}(\omega) \times p_{\perp}) \cdot \mathbf{E}_{s}}{E_{s}^{2}\omega} \, \mathrm{Im}\left[\mathrm{e}^{-i\frac{\omega^{2}}{4eE_{s}}} {}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 1; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right) \right] \right|^{2} \\ &+ \left| \int_{0}^{\infty} d\omega \, \mathrm{e}^{-i\frac{\omega p_{\parallel}}{eE_{s}}} \frac{m}{\omega} \frac{\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{f}}(\omega) + is\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{f}}^{\mathrm{y}}(\omega)}{E_{s}} \, \mathrm{Im}\left[\mathrm{e}^{-i\frac{\omega^{2}}{4eE_{s}}} {}_{1}F_{1}\left(1 - \frac{i}{2}\frac{m^{2}+p_{\perp}^{2}}{eE_{s}}; 1; \frac{i}{2}\frac{\omega^{2}}{eE_{s}}\right) \right] \right|^{2} \end{aligned}$$

・見た目はとても複雑になった(赤 = new terms)が、基本的な構造は同じ



・見た目はとても複雑になった(赤 = new terms)が、基本的な構造は同じ

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{l} \frac{d^{3}N_{e}}{dp^{3}} = \underbrace{V}_{(2\pi)^{3}} \exp \left[\begin{array}{c} \underline{B} \underline{B} \\ \underline{B} \\ \underline{B} \\ \underline{B} \\ \underline{C} \\ \underline{C$$

・見た目はとても複雑になった(赤 = new terms)が、基本的な構造は同じ

- ・見た目はとても 複れ になった(赤 = new terms)が、基本的な構造は同じ
- ・スピンに依存する!

⇒ Dirac粒子のスピン軌道相互作用*s* · (*p* × *E*)によって、磁場がなくてもスピン偏極 e.g. スピントロニクスへの応用 [Huang, Matsuo, <u>HT</u> (2019)]

結果(3/3): 全粒子数Nのプロット

強い定常電場 E_s = const. + 平行な方向に、単色の弱く速い振動電場 $\mathcal{E}_f = \mathcal{E} \cos \omega t$





結果(3/3): 全粒子数Nのプロット

強い定常電場 E_s = const. + 平行な方向に、単色の弱く速い振動電場 $\mathcal{E}_f = \mathcal{E} \cos \omega t$



・完全にFranz-Keldysh効果と同じ振る舞い

⇒ ギャップの (1) 下では、生成数が増大; (2) 上では、生成数が振動 [Dunne, Gies, Schutzhold (2008), (2009)] [Piazza et al (2009)][Monin, Voloshin (2010)]





まとめ

考えた 「強い遅い電場 + <u>任意に</u>時間依存する弱い電場」をかけた ときのSchwinger機構 (dynamically assisted Schwinger 機構)



Schwinger公式を超える、解析的公式をはじめて導出 ⇒これまで解析的に議論できなかったパラメタ領域の議論が可能に



- ・ dynamically assisted Schwinger 機構と
 物性のFranz-Keldysh効果は本質的に同じものである
 ⇒ ギャップの下では生成数が増大; 上では生成数が振動
- ・スピン依存する粒子生成が起こる

⇒ スピントロニクスへも応用可 [Huang, Matsuo, <u>HT</u>, to appear in PTEP]



Interpretation of the oscillation



✓ quantum tunneling → dynamically assisted Schwinger mechanism

- ✓ quantum reflection → FK oscillation
 - non-uniform prob. dist. due to interference b/w in-coming and reflected waves
 - production occurs most efficiently at the maxima

Momentum distribution d^3N_e/dp^3



- ✓ FK effect: enhancement below threshold & oscillation above threshold
- ✓ the location of the perturbative peak is modified due to reflection
- ✓ excellent agreement b/w our analytical formula and numerical results



遅い電場と速い電場が平行でなければ、 スピン軌道相互作用を通じて、スピン流が流れる

電子・正孔が電場により作られ、電場の方向に電流を流そうとする

電流は、速い電場の変化に追随しようとするが、タイムラグがある ⇒ **電流と電場は厳密に平行でない** $j \times E \neq 0$

Dirac粒子は、 $s \cdot (j \times E)$ の形のスピン軌道相互作用を必ず持つ

cf.・電場の中で運動をしている電子の静止系では、電場は磁場に見える

・Dirac方程式の非相対論近似で導出可 [Foldy, Wouthuysen (1950)]

2つの電場と直交する方向にスピン偏極し、スピン流が流れる

結果(1/2): スピン流生成



- ・予想したように、電場(x,z軸)に垂直な方向(y軸)にスピン偏極した スピン流が、電場の方向(x,z軸)が確かに流れている (緑、黄)
- ・電場の方向(x,z軸)にも少しだけスピン偏極する(赤、青)

結果(2/2): 相対論的効果 (ヘリシティ保存)



・質量が軽いと、相対論的効果で、スピンと運動方向が同じ方向に向こうとする ⇒ 非ゼロの $(J_{s^i})^j$ が、非ゼロの $(J_{s^j})^i$ を産む ⇒ 解析的にも、証明可: $\frac{(J_{s^i})^j - (J_{s^j})^i}{(J_{s^i})^j + (J_{s^j})^i} \xrightarrow{m \to 0} 0$